

- 金属有机物气相外延法生长 InGaN
- 正装芯片 (图形衬底提高亮度)
- ※ 每颗样品都经过测试和分检,且用户可以咨询特殊规格。

## 绝对极限范围 (Ta = 25 °C)

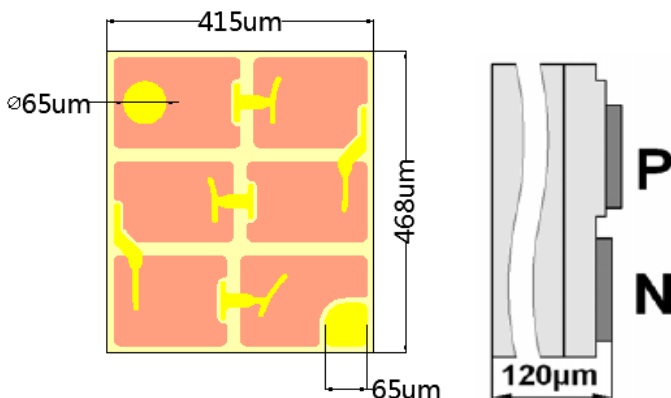
项目	符号	极限范围	单位
正向直流	IF	30	毫安
正向脉冲电流	IFP	100	毫安
工作温度	T <sub>opr</sub>	-30 to +85	摄氏度
贮藏温度	T <sub>stg</sub>	-40 to +100	摄氏度
抗静电能力 (人体静电模式) *	VESDS	500	伏特

\*说明:ESD水平为500V全测合格;

## 光学和电学参数 (Ta = 25 °C)

项目	符号	条件		最小值	典型值	最大值	单位
开启电压	VFin	IFin=10μA	V	13.5	-	16.5	伏特
正向电压	VF	IF=26mA	V1	18	-	18.5	伏特
			V2	18.5	-	19.5	
			V3	19.5	-	20	
反向漏电	IR	VR=-60V		-	-	0.5	微安
主波长	λD	IF=26mA	W1	447.5	-	450	纳米
			W2	450	-	452.5	
			W3	452.5	-	455	
			W4	455	-	457.5	
			W5	457.5	-	460	
			W6	460	-	462.5	
光功率	P	IF=26mA	P1	155	-	170	毫瓦
			P2	170	-	180	
			P3	180	-	190	
			P4	190	-	210	

## 芯片描述



## 机械规范

描述	尺寸
发光区面积	393μm x 446μm (±10μm)
芯片面积	415μm x 468μm (±10μm)
芯片厚度	120μm (±5μm)
N电极	65μm
P电极	65μm
电极间距	10μm
电极材料	铝